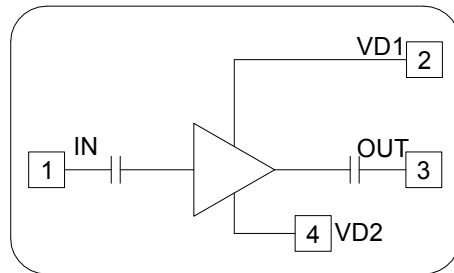


**特点:**

- 频率: 16~40GHz
- 增益: 24dB
- 输出 P-1dB 压缩点: 10dBm
- 工作电压电流: +3V@91mA
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 1.75×1.2×0.1mm

**功能框图**

**性能参数: (T<sub>A</sub>=+25℃, VD=+3V, ID=91mA)**

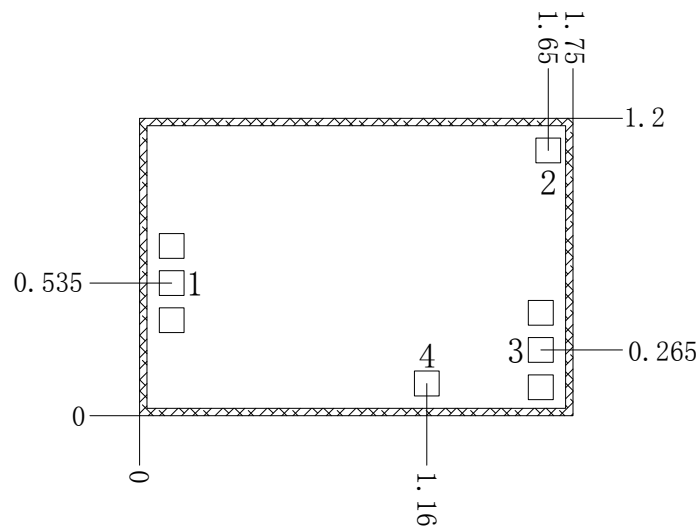
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	VD=+3.0V Z <sub>in</sub> =Z <sub>out</sub> =50Ω	16		40	GHz	
增益	G		17	24		dB	
输入驻波	VSWR <sub>i</sub>			1.6	3		
输出驻波	VSWR <sub>o</sub>			1.6	2		
噪声系数	NF			2	3.5	dB	
输出 P <sub>-1</sub>	P <sub>-1</sub>				10	dBm	
电压	VD			2.75	3	3.25	V
电流	ID	VD=+3.0V		91	120	mA	

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+3.5	V	贮存温度	-55~+150	℃

**芯片尺寸图:**

单位: mm

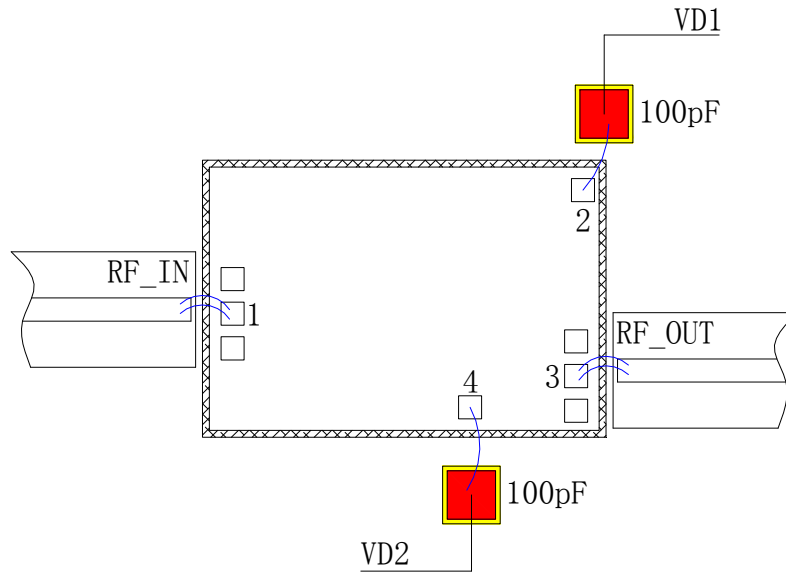


注: 典型键合焊盘尺寸为 100\*100um

**引脚定义:**

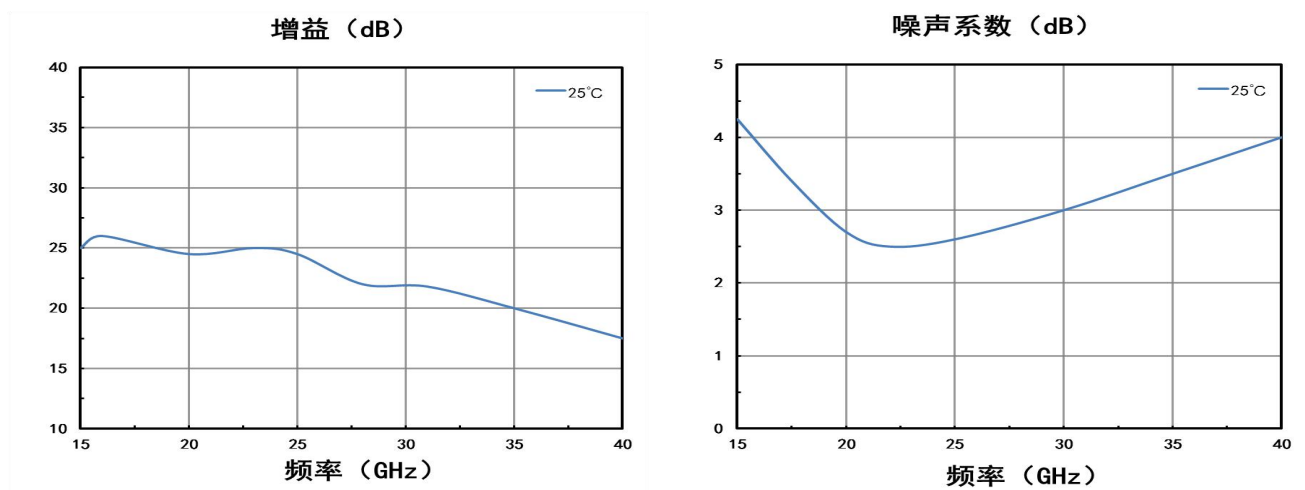
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入, AC 耦合
2, 4	VD1, VD2	放大器电源电压, 需外接 100pF 旁路电容
3	OUT	射频输出, AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

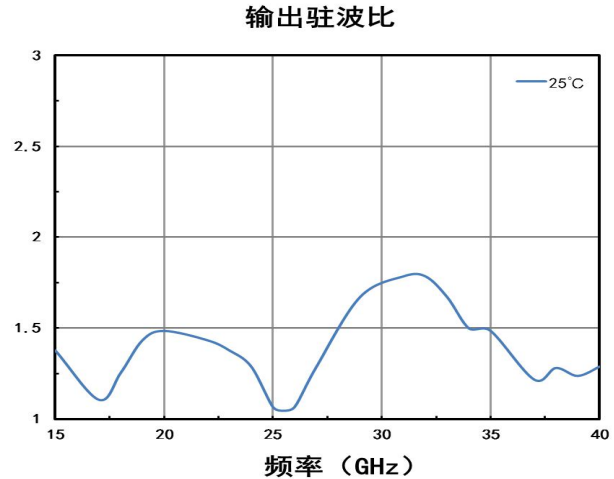
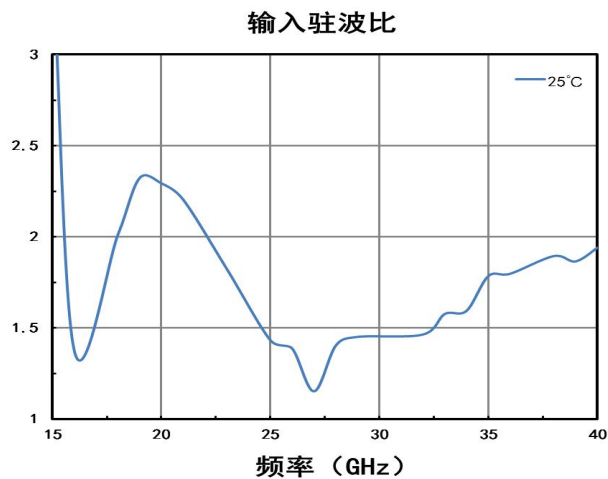
**推荐装配图:**



注: 未标注的键合焊盘不需要连接

**典型测试曲线:**





### 产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。